(19) [本国特許庁(JP)

(51) Int.Cl.5

餓別記号

(12) 公開特許公報(A)

庁内整理番号

(11)特許出願公開番号

特開平5-1148

(43)公開日 平成5年(1993)1月8日

技術表示箇所

C 0 8 G 73/10 G 0 2 B 1/04 6/00 6/12	NTF 9285-4J 7132-2K 3 9 1 7036-2K N 7036-2K	審査請求 未請求 請求項の数49(全 21 頁)
(21)出願番号	特顏平3-235020	(71)出願人 000004226 日本電信電話株式会社 東京都千代田区内幸町一丁目1番6号
(22) 出顧日	平成3年(1991)9月13日	(72) 発明者 安藤 慎治
(31) 優先権主張番号 (32) 優先日	特額平2-256843 平 2 (1990) 9 月28日	東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式会社内
(33) 優先権主張国 (31) 優先権主張番号 (32) 優先日	日本 (JP) 特顯平3-106552 平 3 (1991) 4月12日	(72)発明者 松浦 徹 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日 本電信電話株式会社内
(33) 優先権主張国 (31) 優先権主張番号 (32) 優先日	日本(JP) 特願平3-106554 平3(1991)4月12日	(72)発明者 佐々木 重邦 東京都千代田区内辛町1丁月1番6号 日 本電信電話株式会社内
(33) 優先権主張国 日本 (JP)		(74)代理人 弁理士 谷 義一 (外1名) 最終頁に続く

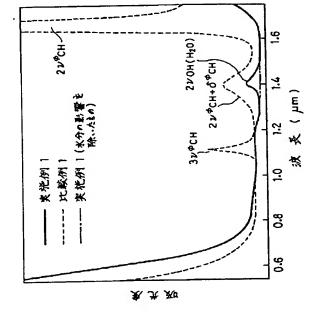
FΙ

(54) 【発明の名称】 全フツ索化ポリイミド、その中間体および出発物質およびそれらの製造方法ならびに全フツ案化 ポリイミド光学材料

(57)【要約】

【構成】 1,4-ビス(3,4-ジカルボキシトリフルオロフェノキシ)テトラフルオロベンゼン二無水物、1,4-ジフルオロピロメリット酸二無水物または1,4-ビス(トリフルオロメチル)ピロメリット酸二無水物と、テトラフルオロー1,3-フェニレンジアミン、テトラフルオロー1,4-フェニレンジアミン、ピス(4-アミノーテトラフルオロフェニル)エーテルまたはビス(4-アミノーテトラフルオロフェニル)スルフィドとから全フッ素化ポリアミド酸を合成し、加熱関環して全フッ素化ポリイミドを得、これを主構成要素とする光学材料とする。1,4-ビス(3,4-ジカルボキシトリフルオロフェノキシ)テトラフルオロベンゼンニ無水物等の合成法も示す。

【効果】 全フッ素化ポリイミドは耐熱性を有するとともに $1.0\sim1.7\mu$ mの光通信波長全域で光損失が低い。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(1):

(化1)

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c & c \\ N & R_1 & N - R_2 \end{pmatrix}$$

(式中R1 は4価の有機基、R: は2価の有機基を示 し、 R_1 および R_2 に含まれる炭素と一価元素の化学結 10合として炭素-フッ素結合のみを含む) で表わされる繰 り返し単位を有することを特徴とする全フッ素化ポリイ ₹ F.

上記一般式(1)においてR1が下記一 【請求項2】 般式(2):

【化2】

(式中Rfはフッ森、ペルフルオロアルキル基、ペルフ ルオロアリール基、ペルフルオロアルコキシ基、または ペルフルオロフェノキシ基を示す) で表わされる構造で あることを特徴とする請求項1に記載の全フッ案化ポリ イミド。

上記一般式(1)においてR1は下記一 【請求項3】 般式(3):

【化3】

(式中Rfはフッ素、ペルフルオロアルキル基、ペルフ ルオロアリール基,ペルフルオロアルコキシ基、または ペルフルオロフェノキシ基を表わし、Xは単なる原子価 446、

-0 -, -C0-, $-S0_2$ -, -S -, -Rf' -, -(ORf')。-、-(Rf'0)。-、または-(ORf'0)。-(式中R f ' はペルフルオロアルキレン基またはペルフ ルオロアリーレン基を表わし、nは1~10の整数を示 す)を表わすか、あるいはXとこれに隣接する二つのR f はそれらが結合している炭素原子とともに飽和もしく は不飽和の5または6員環でOもしくはSから選ばれた 最大2個のヘテロ原子を含んでいてもよい環を形成する か、またはベンゼン縮合環の共有辺を表わす)で表わさ れる構造であることを特徴とする請求項1に記載の全フ ッ素化ポリイミド。

子価結合、

素化ポリイミド。

-0 -, -c0-, -s0₂ -, -s -, -Rf' -, **−(ORf′)。−、−(Rf′0)。−、または−(ORf′0)。−** (式中R f'はペルフルオロアルキレン基またはペルフ ルオロアリーレン基を表わし、nは1~10の整数を示 す)を表わすことを特徴とする請求項3に記載の全フッ

2

上記一般式 (1) においてR2 が下記一 【請求項5】 般式(4):

【化4】

(式中Rfはフッ素、ペルフルオロアルキル基、ペルフ ルオロアリール基,ペルフルオロアルコキシ基、または ペルフルオロフェノキシ基を示す)で表わされる構造で あることを特徴とする請求項1に記載の全フッ素化ポリ 20 イミド。

上記一般式(1)においてR:が下記一 【請求項6】 般式(5):

【化5】

(式中Rfはフッ素、ペルフルオロアルキル基、ペルフ 30 ルオロアリール基,ペルフルオロアルコキシ基、または ペルフルオロフェノキシ基を表わし、Xは単なる原子価 結合、

-0 -, -C0-, $-S0_2$ -, -S -, -Rf' -, -(ORI')。-、-(RI'0)。-、または-(ORI'0)。-(式中R f ' はペルフルオロアルキレン基またはペルフ ルオロアリーレン基を表わし、nは1~10の整数を示 す)を表わすか、あるいはXとこれに隣接する二つのR f はそれらが結合している炭素原子とともに飽和もしく は不飽和の5または6員環でOもしくはSから選ばれた 最大 2 個のヘテロ原子を含んでいてもよい環を形成する か、またはペンゼン縮合環の共有辺を表わす)で表わさ れる構造であることを特徴とする請求項1に記載の全フ ッ素化ポリイミド。

【請求項7】 上記一般式(5)においてXは単なる原 子価結合、

-0 -, -C0-, $-S0_2$ -, -S -, -Rf' -,

-(ORf')。-、-(Rf'0)。-、または-(ORf'0)。-(式中R f ' はペルフルオロアルキレン基またはペルフ ルオロアリーレン基を表わし、nは1~10の整数を示 【請求項4】 上記一般式(3)においてXは単なる原 50 す)を表わすことを特徴とする請求項6に記載の全フッ

素化ポリイミド。

【請求項8】 下記一般式(6):

[化6]

$$\begin{pmatrix}
0 & 0 & 0 \\
N \cdot C & C \cdot N - R_2 \\
H \cdot C \cdot N - R_2 \\
0 & C \cdot OH
\end{pmatrix}$$
(6)

3

(式中R: は4価の有機基、R: は2価の有機基を示し、R: およびR: に含まれる炭素と一価元素の化学結 10 合として炭素-フッ素結合のみを含む)で表わされる繰り返し単位を有することを特徴とする全フッ素化ポリアミド酸。

【請求項9】 上記一般式(6)においてR:が請求項2中に記載の一般式(2)で表わされる構造であることを特徴とする請求項8に記載の全フッ素化ポリアミド酸。

【請求項10】 上記一般式(6)においてR1 が請求項3中に記載の一般式(3)で表わされる構造であることを特徴とする請求項8に記載の全フッ素化ポリアミド 20 酸。

【請求項11】 上記一般式(3)においてXは単なる原子価結合、

-0 -, -C0-, $-S0_z$ -, -S -, -Rf' -,

 $-(ORf')_a$ -、 $-(Rf'0)_a$ -、または $-(ORf'0)_a$ - (式中Rf'はペルフルオロアルキレン基またはペルフルオロアリーレン基を表わし、nは $1\sim10$ の整数を示す)を表わすことを特徴とする請求項10に記載の全フッ素化ポリアミド酸。

【請求項12】 上記一般式(6)においてR2 が請求 30 項5中に記載の一般式(4)で表わされる構造であることを特徴とする請求項8に記載の全フッ素化ポリアミド酸。

【請求項13】 上記一般式(6)においてR2 が請求項6中に記載の一般式(5)で表わされる構造であることを特徴とする請求項8に記載の全フッ素化ポリアミド酸。

【請求項14】 上記一般式(5)においてXは単なる原子価結合、

-0 -, -C0-, $-S0_2$ -, -S -, -Rf' -,

-(ORf')。-、-(Rf'0)。-、または-(ORf'0)。-(式中Rf'はペルフルオロアルキレン基またはペルフルオロアリーレン基を表わし、nは $1\sim10$ の整数を示す)を表わすことを特徴とする請求項13に配載の全フッ素化ポリアミド酸。

【請求項15】 下記一般式(7) 【化7】

$$\begin{array}{c} R_4 \\ R_4 \end{array} \qquad \begin{array}{c} R_4 \\ R_4 \end{array} \qquad (7)$$

(式中R。は下記式(8)または(9) 【化8】

で表わされる四価のベルフルオロ芳香族基を示し;4個のR』はすべてカルボキシル基を表わすか、またはすべてシアノ基を示し、あるいは二組の隣接する2個のR』同士が結合してそれぞれ下式(10)

【化9】

で表わされる二価の基を示し、R₄がすべてシアノ基を 示すときはR₄は式(9)で表わされる基のみを示す) で表わされることを特徴とするペルフルオロ芳香族化合 物

【請求項16】 下記式(11): 【化10】

で表わされる1,4-ビス(3,4-ジカルポキシトリフルオロフェノキシ)テトラフルオロベンゼン二無水物。

【請求項17】 下記式(12):

【化11】

で表わされる1,4ージフルオロ無水ピロメリット酸。 【請求項18】 下記式(13):【化12】

で表わされる1, 4-ピス(3, 4-ジカルボキシトリフルオロフェノキシ)テトラフルオロベンゼン。

50 【請求項19】 下記式(14):

(4k 1 3)

$$\begin{array}{c}
NC \\
NC
\end{array}$$
 $\begin{array}{c}
F \\
F
\end{array}$
 $\begin{array}{c}
F \\$

【請求項20】 下記式(15):

【化14】

$$HO_{2C} \xrightarrow{F} \varpi_{2}H \qquad (15)$$

で表わされる 1, 4 - ジフルオロピロメリット酸。

【請求項21】 下記一般式(1):

【化15]

$$\begin{pmatrix}
0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 \\
N & N - R_2 & 0 & 0
\end{pmatrix}$$
(1)

(式中R、は4価の有機基、R:は2価の有機基を示し、R: およびR:に含まれる炭素と一価元素の化学結合として炭素-フッ素結合のみを含む)で表わされる繰り返し単位を有する全フッ素化ポリイミドを主構成要素とすることを特徴とするポリイミド光学材料。

【請求項22】 上記一般式(1)においてR₁が請求 項2中に記載の一般式(2)で表わされる構造であるこ 30 とを特徴とする請求項21に記載のポリイミド光学材

【請求項23】 上記一般式(1)においてR、が請求項3中に記載の一般式(3)で表わされる構造であることを特徴とする請求項21に記載のポリイミド光学材料。

【請求項24】 上記一般式(3) においてXは単なる 原子価結合、

-0 -, -C0-, $-S0_2$ -, -S -, -Rf' -,

-(ORf')。-、-(Rf'0)。-、または-(ORf'0)。-(式中Rf'はペルフルオロアルキレン基またはペルフルオロアリーレン基を表わし、nは1~10の整数を示す)を表わすことを特徴とする請求項23に記載のポリイミド光学材料。

【請求項25】 上記一般式(1)においてR2が請求項5中に記載の一般式(4)で表わされる構造であることを特徴とする請求項21に記載のポリイミド光学材料。

【請求項26】 上記一般式(1)においてR₂が請求 項6中に記載の一般式(5)で表わされる構造であるこ *50*

とを特徴とする請求項21に記載のポリイミド光学材 *5

【請求項27】 上記一般式(5)においてXは単なる 原子価結合、

-0 -, -C0-, $-S0_2$ -, -S -, -Rf' -,

-(ORf')。-、-(Rf'0)。-、または-(ORf'0)。-(式中Rf'はペルフルオロアルキレン基またはペルフルオロアリーレン基を表わし、nは1~10の整数を示す)を表わすことを特徴とする請求項26に記載のポリ 10 イミド光学材料。

【請求項28】 「記一般式(6):

(化16]

(式中R: は4価の有機基、R: は2価の有機基を示し、R: およびR: に含まれる炭素と一価元素の化学結 20 合として炭素-フッ素結合のみを含む)で表わされる繰り返し単位を有する全フッ素化ポリアミド酸を閉環させることを特徴とする全フッ素化ポリイミドの製造方法。

【請求項29】 上記一般式(6) においてR1 が請求項2中に記載の一般式(2) で表わされる構造であることを特徴とする請求項28に記載の全フッ素化ポリイミドの製造方法。

【請求項30】 上記一般式(6) においてR1 が請求項3中に記載の一般式(3) で表わされる構造であることを特徴とする請求項28に記載の全フッ素化ポリイミドの製造方法。

【請求項31】 上記一般式(3)においてXは単なる 原子価結合。

-0 -, -C0-, $-S0_2$ -, -S -, -Rf' -,

-(ORI')。-、-(RI'0)。-、または-(ORI'0)。-(式中RI'0)。-(式中RI'1)。 -(式中RI'1) はペルフルオロアルキレン基またはペルフルオロアリーレン基を表わし、nは $1\sim10$ の整数を示す)を表わすことを特徴とする簡求項 30 に配載の全フッ素化ポリイミドの製造方法。

【請求項32】 上記一般式(6)においてR2が請求 40 項5中に記載の一般式(4)で表わされる構造であることを特徴とする請求項28に記載の全フッ素化ポリイミドの製造方法。

【請求項33】 上記一般式(6)においてR2 が請求項6中に記載の一般式(5)で表わされる構造であることを特徴とする請求項28に記載の全フッ素化ポリイミドの製造方法。

【請求項34】 上記一般式(5)においてXは単なる 原子価結合、

-0 -、-CO-、-SO₂ -、-S -、-Rf'-、 -(ORf')。-、-(Rf'0)。-、または-(ORf'0)。-

-426-

(5)

10

(式中Rf'はベルフルオロアルキレン基またはベルフ ルオロアリーレン甚を表わし、nは1~10の整数を示 す)を表わすことを特徴とする請求項33に記載の全フ ッ素化ポリイミドの製造方法。

【請求項35】 下記一般式(16):

【化17】

H₂ N-R₂ -NH₂

(式中R2 は2価の有機基を示し、それに含まれる炭素 と一価元素の化学結合として炭素-フッ素結合のみを含 む)で表わされるジアミンとを反応させることを特徴と する全フッ素化ポリアミド酸の製造方法。

【請求項36】 上記一般式(16)においてR1 が請 求項2中に記載の一般式(2)で表わされる構造である ことを特徴とする請求項35に記載の全フッ素化ポリア ミド酸の製造方法。

【請求項37】 上記一般式(16)においてR1 が請 求項3中に記載の一般式(3)で表わされる構造である ことを特徴とする請求項35に記載の全フッ素化ポリア ミド酸の製造方法。

【請求項38】 上記一般式(3)においてXは単なる 原子価結合、

-0 -, -C0-, $-S0_2$ -, -S -, -Rf' -, -(ORf'),-、-(Rf'0),-、または-(ORf'0),-(式中R f ' はペルフルオロアルキレン基またはペルフ ルオロアリーレン基を表わし、nは $1\sim10$ の整数を示30 ロフェノキシ)テトラフルオロベンゼンの製造方法。 す)を表わすことを特徴とする請求項37に記載の全フ ッ素化ポリアミド酸の製造方法。

【請求項39】 上記一般式 (17) においてR2 が請 求項5中に記載の一般式(4)で表わされる構造である ことを特徴とする請求項35に記載の全フッ案化ポリア ミド酸の製造方法。

【請求項40】 上記一般式(17)においてR2 が請 求項6中に記載の一般式(5)で表わされる構造である ことを特徴とする請求項35に記載の全フッ案化ポリア ミド酸の製造方法。

【請求項41】 上記一般式(5)においてXは単なる 原子価結合、

-0 -, -C0-, -S0₂ -, -S -, -Rf' -, -(ORf')。-、-(Rf'0)。-、または-(ORf'0)。-(式中R f ' はペルフルオロアルキレン基またはペルフ ルオロアリーレン基を表わし、nは1~10の整数を示 す)を表わすことを特徴とする請求項40に記載の全フ ッ素化ポリアミド酸の製造方法。

【請求項42】 請求項18中に記載の式(13)で表 わされる1, 4-ビス(3, 4-ジカルボキシトリフル 50

* (式中R1 は4価の有機基を示し、それに含まれる炭素 と一価元素の化学結合として炭素-フッ素結合のみを含 む) で表わされるテトラカルポン酸二無水物またはその テトラカルボン酸、もしくはその反応性誘導体と、 下記一般式(17):

(17)

オロフェノキシ) テトラフルオロベンゼンを脱水するこ とを特徴とする請求項16中に記載の式(11)で表わ される1, 4-ピス(3, 4-ジカルポキシトリフルオ ロフェノキシ) テトラフルオロペンゼン二無水物の製造 方法。

【請求項43】 請求項19中に記載の式(14)で表 わされる1, イーピス(3, イージシアノトリフルオロ 20 フェノキシ) テトラフルオロペンゼンを硫酸中で加水分 解と脱水反応を一段階で行うことを特徴とする請求項1 6 中に記載の式 (11) で表わされる 1, 4-ピス (3, 4-ジカルボキシトリフルオロフェノキシ)テト ラフルオロベンゼン二無水物の製造方法。

【請求項44】 請求項19中に記載の式(14)で表 わされる1, 4-ピス(3, 4-ジシアノトリフルオロ フェノキシ)テトラフルオロベンゼンを加水分解するこ とを特徴とする請求項18中に記載の式(13)で表わ される1, 4-ピス(3, 4-ジカルポキシトリフルオ

【請求項45】 テトラフルオロフタロニトリルとテト ラフルオロヒドロキノンを塩基存在下に反応させること を特徴とする請求項19中に記載の式(14)で表わさ れる1,4-ビス(3,4-ジシアノトリフルオロフェ ノキシ) テトラフルオロペンゼンの製造方法。

【簡求項46】 テトラフルオロフタロニトリルとテト ラフルオロヒドロキノンの金属塩とを反応させることを 特徴とする請求項19中に記載の式(14)で表わされ る1、4-ビス(3,4-ジシアノトリフルオロフェノ 40 キシ) テトラフルオロベンゼンの製造方法。

【請求項47】 請求項20中に記載の式(15)で表 わされる1,4-ジフルオロピロメリット酸を脱水する ことを特徴とする請求項17中に記載の式(12)で表 わされる1, 4-ジフルオロ無水ピロメリット酸の製造

【請求項48】 下記式(18): [化18]

で表わされる 1, 4 ージフルオロテトラシアノペンゼン を硫酸中で加水分解と脱水反応を一段階で行うことを特 徴とする請求項 1 7 中に記載の式 (12) で表わされる 1, 4 ージフルオロ無水ビロメリット酸の製造方法。

【請求項49】 請求項48中に配載の式(18)で表わされる1,4ージフルオロテトラシアノベンゼンを加水分解することを特徴とする請求項20中に記載の式(15)で表わされる1,4ージフルオロピロメリット酸の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はフッ素化ポリイミド光学材料に関し、特に光電子集積回路(OEIC)や光電子混載実装配線板における光導波路の光学材料として使用可能な、近赤外光に対する透過損失の少ないフッ素化ポリイミド光学材料に関する。さらに、本発明はそのような光学材料の主要構成要素として使用可能なフッ素化ポリイミド、その前駆体(中間体)であるフッ素化ポリアミド酸およびその出発物質であるフッ素化テトラカルボン酸二無水物とフッ素化ジアミン等ならびにそれらの製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】プラスチック材料は、無機系の材料に比 べて軽量であり、対衝撃性、加工性に優れ、取扱いが容 易であるなどの特長を有しているため、これまでも光フ 30 ァイバーやレンズ、光ディスク用基板など様々な光学用 途に用いられてきた。プラスチックをOEICや光電子 混載実装配線板の光導波路など、光通信用の近赤外光を 透過させる媒体として用いる場合、無機系の材料と比較 してまず問題となるのは大きな光透過損失である。プラ スチックにおける透過損失の原因には大きく分けて散乱 と吸収の2つがあるが、通信用途に用いられる光の波長 が今後、長波長域へ移る(0. 85μmから1. 0μm ~ 1 . $7 \, \mu \, \mathrm{m}$ へ)に従って、後者の原因、つまり分子構 造に本質的な赤外振動の高調波吸収による損失が支配的 40 となり、プラスチックの光通信用途への適用が困難とな ることが危惧されている。特にこれまで可視光用の光学 材料として広く用いられてきたポリメチルメタクリレー ト(PMMA)やポリスチレン(PS)は、分子鎖内に 2 種類以上の炭素-水素結合 (C-H結合) を有するた め、その近赤外吸収スペクトルには、幅広で強度の大き な吸収ピークが複数存在している。このC-H結合に起 因する高調波吸収を長波長側へシフトさせ強度を低減さ せるには、 重水素 (D) あるいはフッ素 (F) による分 子内水素の置換が効果的であることが示されており、す 50 10

でにPMMAやPS中の水素を重水素あるいはフッ素で 置換した材料について基礎的な検討がなされている [例えば戒能俊邦、アプライド フィジクス レターズ (Appl. Phys. Lett.) 第48巻 (12) 757頁1986年参照]。しかし、これらのプラスチック 光学材料は、例えばシリコン基板上でのOEIC作製に必要なハンダ耐熱性 (260℃)を持たないため、OEIC等に使用するには作製工程上の種々の工夫が必要となる。

[0003] 一方、ポリイミド樹脂は一般的な熱分解開始温度が400℃以上とプラスチック中で最も高い耐熱性を持つものの一つとして知られており、光学材料への適用も最近検討され始めている[例えばH. Franke, J. D. Crow, SPIE vol. 651 Integrated Optical Circuit Engineering III pp. 102-107 (1986)、C. T. サリバン, SPIE第994巻92頁1988年参照]。

【0004】また、透明性を改善した耐熱性材料として ヘキサフルオロイソプロピリデン基を含有する含フッ素 ポリイミド樹脂コーティング材料 [Anne K. S t. Clair and Wayne S. Slem p, SAMPE Journal July/Augus t pp. 28-33 (1985)] が検討され、光損 失を低減するためヘキサフルオロイソプロピリデン基を 主鎖に含有する含フッ素ポリイミド樹脂を用いた光導波 路 [Rainer Reuter, HilmarFra nke, and Claudius Feger, Ap plied Optics, Vol. 27, No. 21 pp. 4565-4571 (1988)] が提案され

【0005】しかし、これまでに検討された含フッ素ポリイミドを含む全てのポリイミドは、分子鎖中にフェニル基のC-H結合を有するため、近赤外域の吸収スペクトルにはC-H結合の伸縮振動の高調波あるいはC-H結合の伸縮信号の高調波と変角振動の結合振動に由来するピークが存在している。このため、光通信波長域(1.0~1.7 μm)の全域にわたって低い光損失が達成されることがない。

【0006】そこでこれらの水素をすべて重水素あるいはフッ素で置き換えることができれば光通信波長域における吸収損失は大きく低減するはずである。しかし全重水素化ポリイミドや全フッ素化ポリイミドはこれまでに合成例が報告されていない。また、全重水素化はC-D結合の3次高調波が1.5μm付近に存在するため、光通信波長全域での吸収ピーク低減には不十分である。

【0007】従って、通信波長全域における高い光透過性と耐熱性を同時に満足するプラスチック光学材料はこれまでに知られていない。

0 [0008]

【発明が解決しようとする課題】本発明者らは、種々の 既存のポリイミドおよびポリイミド光学材料について、 その赤外域、近赤外域の吸収スペクトルを測定し、近赤 外域での光損失を算出するとともに、その原因について 鋭意検討した。その結果、近赤外域で大きな光損失を引 き起こす原因の第一は、アルキル基やフェニル環等にお けるC-H結合の伸縮振動の高調波と変角振動の結合音 による吸収であることが明らかとなった。

[0009] 従って、本発明の一つの目的は、光電子集積回路を作製するに十分な耐熱性があり、近赤外域光、特に光通信波長域(1.0~1.7 μ m)における光透過損失の極めて少ないプラスチック光学材料を提供することにある。

【0010】本発明の別の目的は、全フッ素化ポリイミドおよびその製造方法を提供することにある。

[0011] 本発明のさらに別の目的は、全フッ素化ポリイミドの前駆体である全フッ素化ポリアミド酸および その製造方法を提供することにある。

【0012】本発明のまた別の目的は、全フッ素化ポリイミドの製造に使用できる出発物質である全フッ素化テ 20トラカルポン酸またはその二無水物およびフッ素化ジアミン(すなわち、炭素と一価元素の化学結合として炭素ーフッ素結合のみを含むジアミン)ならびにそれらの製造方法を提供することにある。

[0013]

【課題を解決するための手段】本発明の第1の観点に従 う全フッ素化ポリイミドは下記一般式(1):

[0014]

【化19】

$$\begin{pmatrix}
0 & 0 \\
C & C \\
N & C \\
C & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & 0 \\
N - R_2 \\
0 & 0
\end{pmatrix}$$
(1)

[0015] (式中R: は4価の有機基、R: は2価の有機基を示し、R: およびR: に含まれる炭素と一価元素の化学結合として炭素-フッ素結合のみを含む)で表わされる繰り返し単位を有することを特徴とする。

【0016】本発明の第2の観点に従う全フッ素化ポリアミド酸は下記一般式(6):

[0017]

【化20]

【0018】(式中R: は4価の有機基、R: は2価の有機基を示し、R: およびR: に含まれる炭素と一価元素の化学結合として炭素-フッ素結合のみを含む)で表 50

12

わされる繰り返し単位を有することを特徴とする。

【0019】本発明の第3の観点に従うベルフルオロ芳香族化合物は下記一般式(7)

[0020]

【化21】

$$\begin{array}{c} R_4 \\ R_4 \end{array} \qquad R_5 \begin{array}{c} R_4 \\ R_4 \end{array} \qquad (7)$$

【0021】 (式中R。は下記式(8)または(9)

[0022]

【化22】

【0023】で表わされる四価のベルフルオロ芳香族基 かまたし:4個のR・はすべてカルボキシル基を表わす か、またはすべてシアノ基を示し、あるいは二組の隣接 する2個のR・同士が結合してそれぞれ下式(10)

[0024]

【化23】

【0025】で表わされる二価の基を示し、R4がすべてシアノ基を示すときはR3は式(9)で表わされる基 のみを示す)で表わされることを特徴とする。

【0026】本発明の第4の観点に従う化合物は下記式(11):

[0027]

【化24】

[0028] で表わされる1, 4-ピス(3, 4-ジカルボキシトリフルオロフェノキシ) テトラフルオロベンゼン二無水物である。

【0029】本発明の第5の観点に従う化合物は下記式

(12):

[0030]

【化25】

40

【0031】で表わされる1、4-ジフルオロ無水ピロ メリット酸である。

【0032】本発明の第6の観点に従う化合物は下記式

(13):

[0033]

【化26】

【0034】で表わされる1、4-ピス(3、4-ジカ ルポキシトリフルオロフェノキシ) テトラフルオロベン ゼンである。

[0035] 本発明の第7の観点に従う化合物は下記式 20

(14):

[0036]

【化27】

【0037】で表わされる1、4-ピス(3、4-ジシ アノトリフルオロフェノキシ) テトラフルオロペンゼン 30 である。

【0038】本発明の第8の観点に従う化合物は下記式

(15):

[0039]

【化28】

【0040】で表わされる1、4-ジフルオロピロメリ ット酸である。

【0041】本発明の第9の観点に従うポリイミド光学* $H_2 N - R_2 - NH_2$

(式中R2 は2価の有機基を示し、それに含まれる炭素 と一価元素の化学結合として炭素-フッ素結合のみを含 む) で表わされるジアミンとを反応させることを特徴と する。

【0050】本発明の第12の観点に従う式(11)で

*材料は下記一般式(1):

[0042]

[化29]

$$\begin{pmatrix}
0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0
\end{pmatrix}$$
(1)

14

【0043】 (式中R: は4価の有機基、R: は2価の 10 有機基を示し、R1 およびR2 に含まれる炭素と一価元 素の化学結合として炭素-フッ素結合のみを含む)で表 わされる繰り返し単位を有する全フッ案化ポリイミドを 主構成要素とすることを特徴とする。

【0044】本発明の第10の観点に従う全フッ衆化ポ リイミドの製造方法は下記一般式(6):

[0045]

[化30]

$$\begin{pmatrix}
0 & 0 & 0 & 0 \\
N - C & C - N - R_2 & 0 & 0 \\
H - C & C - OH & 0 & 0
\end{pmatrix}$$
(6)

【0046】(式中R1 は4価の有機基、R1 は2価の 有機基を示し、R1 およびR2 に含まれる炭素と一価元 素の化学結合として炭素-フッ素結合のみを含む)で表 わされる繰り返し単位を有する全フッ素化ポリアミド酸 を閉環させることを特徴とする。

【0047】本発明の第11の観点に従う全フッ素化ポ リアミド酸の製造方法は下記一般式(16):

[0048]

【化31】

[004.9] (式中R: は4価の有機基を示し、それに 含まれる炭素と一価元素の化学結合として炭素・フッ素 結合のみを含む) で表わされるテトラカルポン酸二無水 物またはそのテトラカルポン酸、もしくはその反応性誘 導体と、

下記一般式(17):

(17)

ルオロフェノキシ)テトラフルオロベンゼン二無水物の 製造方法は式(13)で表わされる1,4-ピス(3, 4 -ジカルポキシトリフルオロフェノキシ)テトラフル オロベンゼンを脱水することを特徴とする。

【0051】本発明の第13の観点に従う式(11)で

ルオロフェノキシ)テトラフルオロベンゼン二無水物の 製造方法は式(14)で表わされる1,4-ビス(3,4-ジシアノトリフルオロフェノキシ)テトラフルオロ ベンゼンを硫酸中で加水分解と脱水反応を一段階で行う ことを特徴とする。

【0052】本発明の第14の観点に従う式(13)で表わされる1,4ービス(3,4ージカルボキシトリフルオロフェノキシ)テトラフルオロベンゼンの製造方法は式(14)で表わされる1,4ービス(3,4ージシアノトリフルオロフェノキシ)テトラフルオロベンゼンを加水分解することを特徴とする。

【0053】本発明の第15の観点に従う式(14)で表わされる1,4-ビス(3,4-ジシアノトリフルオロフェノキシ)テトラフルオロペンゼンの製造方法はテトラフルオロフタロニトリルとテトラフルオロヒドロキノンを塩基存在下に反応させることを特徴とする。

【0054】本発明の第16の観点に従う式(14)で表わされる1,4-ピス(3,4-ジシアノトリフルオロフェノキシ)テトラフルオロベンゼンの製造方法はテトラフルオロフタロニトリルとテトラフルオロヒドロキ 20ノンの金属塩とを反応させることを特徴とする。

【0055】本発明の第17の観点に従う式(12)で表わされる1,4-ジフルオロ無水ピロメリット酸の製造方法は式(15)で表わされる1,4-ジフルオロピロメリット酸を脱水することを特徴とする。

【0056】本発明の第18の観点に従う式(12)で表わされる1,4-ジフルオロ無水ピロメリット酸の製造方法は式(18)で表わされる1,4-ジフルオロテトラシアノベンゼンを硫酸中で加水分解と脱水反応を一段階で行うことを特徴とする。

[0057] 本発明の第19の観点に従う式(15)で表わされる1,4-ジフルオロピロメリット酸の製造方法は式(18)で表わされる1,4-ジフルオロテトラシアノベンゼンを加水分解することを特徴とする。

[0058]

【作用】本発明の全フッ素化ポリイミドはアルキル基,フェニル環等の炭素に結合するすべての一価元素をフッ素,ペルフルオロアルキル基,ペルフルオロアリール基,ペルフルオロアルコキシ甚,ペルフルオロフェノキシ基のいずれかとし、繰り返し単位内にC-H結合を持たない構造とすることによって、近赤外域での最大の光損失原因であるC-H結合に基づく振動吸収を無くし、またイミド結合を主鎖構造に導入してポリイミドとすることによって、光電子集積回路を作製する上での十分な耐熱性(260℃以上)を持たせている。本発明の全フッ素化ポリイミドは従来のものと比較して、光通信波長域での光透過損失率が極めて小さい。

【0059】全フッ素化ポリイミドの一般的な特徴としては耐熱性,近赤外域における光透過性の他に、低誘電率,低風折率,低吸水性,撥水・撥油性,低摩耗性,高

16

酸素透過性,溶媒溶解性などが考えられる。よってこれ らの特徴を生かした電気,電子材料,膜材料,機維材料,摺動材料などへの適用も可能である。

[0060] 本発明の全フッ素化ポリイミドは下記一般式(1):

[0061]

[化32]

$$\begin{pmatrix}
0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0
\end{pmatrix}$$
(1)

[0062] (式中R: は4価の有機基、R: は2価の有機基を示し、R: およびR: に含まれる炭素と一価元素の化学結合として炭素-フッ素結合のみを含む) で表わされる繰り返し単位を有する。

【0063】R1で示される4価の有機基としては下記一般式(2):

[0064]

90 【化33】

[0065] (式中Rfはフッ素, ペルフルオロアルキル基, ベルフルオロアリール基, ベルフルオロアルコキシ基またはベルフルオロフェノキシ基を示す) で表わされる構造であるか、あるいは下記一般式(3):

30 [0066]

【化34】

【0067】(式中Rfはフッ素、ベルフルオロアルキル基、ベルフルオロアリール基、ベルフルオロアルコキシ基、またはベルフルオロフェノキシ基を表わし、Xは単なる原子価結合、

-0 -、-CO-、-SO₂ -、-S -、-Rf´-、
-(ORf´)。-、-(Rf´O)。-、または-(ORf´O)。(式中R f´はペルフルオロアルキレン基またはペルフルオロアリーレン基を表わし、nは1~10の整数を示す)を表わすか、あるいはXとこれに隣接する二つのRfはそれらが結合している炭素原子とともに飽和もしくは不飽和の5または6員環でOもしくはSから選ばれた最大2個のヘテロ原子を含んでいてもよい環を形成するか、またはペンゼン縮合環の共有辺を表わす)で表わされる構造であるのが好ましい。さらに好ましくはXは単

50

40

なる原子価結合、

-0 -, -C0 -, $-S0_2$ -, -S -, -Rf' -,

-(ORf')。-、-(Rf'0)。-、または-(ORf'0)。-(式中R f ' はペルフルオロアルキレン基またはペルフ ルオロアリーレン基を表わし、nは1~10の整数を示 す)を表わす。

【0068】R2 で示される2価の有機基としては下記 一般式(4):

[0069]

【化35】

【0070】(式中Rfはフッ素、ペルフルオロアルキ ル基、ペルフルオロアリール基、ペルフルオロアルコキ シ基またはベルフルオロフェノキシ基を示す)で表わさ れる構造であるか、または下記一般式(5):

[0071]

【化36】

【0072】 (式中Rfはフッ素, ベルフルオロアルキ ル基、ペルフルオロアリール基、ペルフルオロアルコキ シ基、またはペルフルオロフェノキシ基を表わし、Xは 単なる原子価結合、

-0 -, -C0-, $-S0_2$ -, -S -, -Rf' -, -(ORf')。-、-(Rf'0)。-、または-(ORf'0)。-(式中Rf'はペルフルオロアルキレン基またはペルフ ルオロアリーレン基を表わし、nは1~10の整数を示 す)を表わすか、あるいはXとこれに隣接する二つのR fはそれらが結合している炭素原子とともに飽和もしく は不飽和の5または6員環でOもしくはSから選ばれた 最大2個のヘテロ原子を含んでいてもよい環を形成する か、またはベンゼン縮合環の共有辺を表わす)で表わさ れる構造であるのが好ましい。さらに好ましくはXは単 なる原子価結合、

-0 -, -C0-, $-S0_2$ -, -S -, -Rf' -, -(ORf')。-、-(Rf'0)。-、または-(ORf'0)。-(式中Rf'はペルフルオロアルキレン基またはペルフ ルオロアリーレン基を表わし、nは1~10の整数を示 す)を表わす。

【0073】上記一般式(2)~(5)において、ペル フルオロアルキル基としては、好ましくは炭素数1~4 を有するものであり、トリフルオロメチル基、ペンタフ ルオロエチル基, ヘプタフルオロプロピル基, ノナフル 50

オロブチル基等が例示される。

【0074】ペルフルオロアリール基としてはペンタフ ルオロフェニル基等が例示される。

18

【0075】ペルフルオロアルコキシ基としては、好ま しくは炭素数1~4のものであり、トリフルオロメトキ シ基、ペンタフルオロエトキシ基、ヘプタフルオロプロ ボキシ基、ノナフルオロブトキシ基等が例示される。

【0076】ベルフルオロアルキレン基としては、好ま しくは炭素数1~4であり、ジフルオロメチレン基。テ 10 トラフルオロエチレン基、ヘキサフルオロイソプロピリ デン基,オクタフルオロブチレン基等が例示される。

【0077】ペルフルオロアリーレン基としてはテトラ フルオロフェニレン基、オクタフルオロビフェニレン基 等が例示される。

【0078】上記の式(3)または(5)において、X とこれに隣接する二つのR f とそれらが結合している炭 素原子とが環を形成する場合は、この環を含む縮合環骨 格の例はアントラセン骨格、フェナントレン骨格、ピフ ェニレン骨格、ジベンソフラン骨格、アントラキノン骨 20 格, アントロン骨格, フェノキサチイン骨格, チアント レン骨格, ジゾペンゾ [b, e] 1, 4-ジオキサン骨 格等である。Xとこれに隣接する二つのRfとそれらが 結合している炭素原子とがペンゼン縮合環の共有辺を表 わすときは式(3)または(5)で表わされる環の骨格 はナフタレン骨格である。

【0079】上記一般式(1)で表わされる全フッ素化 ポリイミドは下記一般式(6):

[0080]

[化37]

30

40

【0081】 (式中R: およびR: は上記と同じ意味を 持つ) で表わされるポリアミド酸を加熱閉環することに よって調製できる。この加熱処理は通常空気中好ましく は窒素雰囲気中70~350℃で2~5時間加熱するこ とにより行う。好ましい条件は窒素雰囲気中70℃で2 時間、160℃で1時間、250℃で30分、300℃ で1時間である。

【0082】前駆体として使用される上記一般式(6) の全フッ素化ポリアミド酸は新規化合物であり、下記式 (16):

[0083]

【化38】

 $H_2 N - R_2 - NH_2$

(式中R: は上記と同じ意味を持つ)で表わされるジアミンとを反応させることによって調製される。

【0085】本発明の全フッ素化ポリイミドの前駆体である全フッ素化ポリアミド酸を製造する時に使用するテトラカルポン酸またはその誘導体としては、分子内の炭素に結合する一価元素あるいは一価の官能基のすべてをフッ素、ベルフルオロアルキル基、ベルフルオロアリール基、ベルフルオロアルコキシ基。ベルフルオロフェノキシ基のいずれかとしたものであればどのようなものでもよい。テトラカルポン酸ならびにその誘導体としての酸無水物、酸塩化物、エステル化物等としては次のようなものが挙げられる。

【0086】1、4ージフルオロピロメリット酸、1-トリフルオロメチルー 4.- フルオロピロメリット酸、 1, 4-ジ (トリフルオロメチル) ピロメリット酸、1 **-ペンタフルオロメチル-4-フルオロピロメリット** 酸、1-ペンタフルオロエチル-4-トリフルオロメチ ルピロメリット酸、1,4-ジ(ペンタフルオロエチ ル) ピロメリット酸、1-ペンタフルオロフェニル-4 -フルオロピロメリット酸、1·-ペンタフルオロフェニ ルー4-トリフルオロメチルピロメリット酸、1-ペン タフルオロフェニルー4ーペンタフルオロエチルピロメ リット酸、1,4-ジ(ペンタフルオロフェニル)ピロ メリット酸、1-トリフルオロメトキシー4-フルオロ ピロメリット酸、1ートリフルオロメトキシー4ートリ フルオロメチルピロメリット酸、1-トリフルオロメト キシー4-ペンタフルオロエチルピロメリット酸、1-トリフルオロメトキシー4ーペンタフルオロフェニルピ ロメリット酸、1,4-ジ(トリフルオロメトキシ)ピ ロメリット酸、1-ペンタフルオロエトキシー4-フル オロピロメリット酸、1-ペンタフルオロエトキシー4 - トリフルオロメチルピロメリット酸、1 - ペンタフル オロエトキシー4ーペンタフルオロエチルピロメリット 酸、1-ペンタフルオロエトキシ-4-ペンタフルオロ フェニルピロメリット酸、1-ペンタフルオロエトキシ - 1 - トリフルオロメトキシピロメリット酸、1, 1 -ジ (ペンタフルオロエトキシ) ピロメリット酸、1-ペ ンタフルオロフェノキシー4-フルオロピロメリット 酸、1-ペンタフルオロフェノキシ-4-トリフルオロ メチルピロメリット酸、1 — ペンタフルオロフェノキシ - 4 - ペンタフルオロエチルピロメリット酸、1 - ペン タフルオロフェノキシー4-ペンタフルオロフェニルピ ロメリット酸、1-ペンタフルオロフェノキシー4-ト リフルオロメトキシピロメリット酸、1-ペンタフルオ 50 20

* [0084] (式中R1 は上記と同じ意味を持つ)で表 わされるテトラカルボン酸二無水物またはそのテトラカ ルボン酸、もしくはその反応性誘導体と、 下記一般式 (17)

. .

(17)

ロフェノキシー4ーペンタフルオロエトキシピロメリッ ト酸、1,4-ジ(ペンタフルオロフェノキシ)ピロメ リット酸、ヘキサフルオロー3,3′,4,4′-ピフ ェニルテトラカルボン酸、ヘキサフルオロ-3,3', 4. 4′-ピフェニルエーテルテトラカルポン酸、ヘキ サフルオロー3, 3', 4, 4'ーペンゾフェノンテト ラカルポン酸、ピス (3, 4 - ジカルポキシトリフルオ ロフェニル) スルホン、ピス(3, 4ージカルポキシト リフルオロフェニル) スルフィド、ピス (3, 4ージカ ルポキシトリフルオロフェニル)ジフルオロメタン、 1, 2-ピス(3, 4-ジカルポキシトリフルオロフェ 二ル) テトラフルオロエタン、2,2-ピス(3,4-ジカルボキシトリフルオロフェニル) ヘキサフルオロブ ロパン、1、4-ビス(3、4-ジカルポキシトリフル オロフェニル) テトラフルオロベンゼン、3,4ージカ ルポキシトリフルオロフェニルー3′,4′-ジカルボ キシトリフルオロフェノキシジフルオロメタン、ビス (3, 4-ジカルポキシトリフルオロフェノキシ) ジフ ルオロメタン、1, 2ーピス(3, 4ージカルポキシト リフルオロフェノキシ)テトラフルオロエタン、2,2 - ピス (3, 4 - ジカルポキシトリフルオロフェノキ シ) ヘキサフルオロプロパン、1,4-ビス(3,4-ジカルポキシトリフルオロフェノキシ) テトラフルオロ ベンゼン、2, 3, 6, 7-テトラカルポキシーテトラ フルオロナフタレン、2、3、6、7-テトラカルポキ シーヘキサフルオロアントラセン、2,3,6,7-テ トラカルボキシーヘキサフルオロフェナントレン、2, 3, 6, 7ーテトラカルポキシーテトラフルオロビフェ ニレン、2,3,7,8-テトラカルポキシーテトラフ ルオロジベンソフラン、2,3,6,7-テトラカルボ キシーテトラフルオロアントラキノン、2,3,6,7 - テトラカルポキシーペンタフルオロアントロン、2, 3, 7, 8-テトラカルポキシーテトラフルオロフェノ キサチイン、2,3,7,8-テトラカルポキシーテト ラフルオロチアントレン、2,3,7,8-テトラカル ポキシーテトラフルオロジベンゾ [b. e] 1, 4ージ オキサン、等;対応する酸二無水物;対応する酸塩化 物:対応するエステル化物、例えばメチルエステル,エ チルエステル等。

(0087) これらのうち好ましいのは1,4ービス(3,4ージカルボキシトリフルオロフェノキシ)テトラフルオロベンゼン二無水物、1,4ージフルオロピロメリット酸二無水物、1,4ービス(トリフルオロメチル)ピロメリット酸二無水物である。

【0088】この中でピロメリット酸二無水物のペンゼ ン環にペルフルオロアルキル基を導入した全フッ素化酸 二無水物である1、4-ジ(トリフルオロメチル)ピロ メリット酸二無水物、1,4-ジ(ペンタフルオロエチ ル) ピロメリット酸二無水物等の製造方法は特開平2-15084号に記載されている。

【0089】その他の化合物も例えばプランデリクら (アメリカ化学会高分子予稿集第28巻1号88-89 頁1987年)[D. Brandelik, W. A. ACS Polymer Preprin 10 Feld. t, 28 (1), 88-89 (1987)] の合成方 法、F. E. ロジェースら [米国特許第3, 356, 6 48号および同第3,959,350号明細書]の合成 方法、J. P. クリッチレーら [J. P. Critch ley, P. A. Granttan, M. A. Whi J. S. Pippett, J. Polym. te. Sci. A-1, 10, 1789-1807 (197 2)] の合成方法等あるいは後記実施例に示した1,4 ービス(3, 1 - ジカルポキシトリフルオロフェノキ シ) テトラフルオロベンゼン二無水物の製造方法と同様 20 の方法またはそれらに準じて合成することができる。

【0090】また本発明に用いることのできるジアミン の例としては、アミノ基を除き分子内の炭素に結合する **一価元素あるいは一価の官能基のすべてをフッ素,ペル** フルオロアルキル基,ペルフルオロアリール基,ペルフ ルオロアルコキシ基,ベルフルオロフェノキシ基のいず れかとしたものであればどのようなものでもよく、次の ようなものが挙げられる。

【0091】テトラフルオロー1、2-フェニレンジア ミン、テトラフルオロー1, 3-フェニレンジアミン、 テトラフルオロー1,4-フェニレンジアミン、ヘキサ フルオロー1,5-ジアミノナフタレン、ヘキサフルオ ロー2,6-ジアミノナフタレン、3-トリフルオロメ チルートリフルオロー1,2-フェニレンジアミン、4 ートリフルオロメチルートリフルオロー1,2-フェニ レンジアミン、2ートリフルオロメチルートリフルオロ - 1, 3 - フェニレンジアミン、4 - トリフルオロメチ ルートリフルオロー1,3-フェニレンジアミン、5-トリフルオロメチルートリフルオロー1, 3ーフェニレ ンジアミン、2-トリフルオロメチルートリフルオロー 40 1, 4-フェニレンジアミン、3, 4-ビス(トリフル オロメチル) ージフルオロー1, 2ーフェニレンジアミ ン、3,5-ビス(トリフルオロメチル)ージフルオロ - 1, 2-フェニレンジアミン、2, 4-ピス(トリフ ルオロメチル) -ジフルオロ-1, 3-フェニレンジア ミン、4,5-ビス(トリフルオロメチル)-ジフルオ ロー1, 3-フェニレンジアミン、4,6-ピス(トリ フルオロメチル)-ジフルオロ-1,3-フェニレンジ アミン、2, 3-ピス(トリフルオロメチル)-ジフル オロー1, 4-フェニレンジアミン、2, 5-ピス(ト 50 オロメタン、1, 2-ピス(4-アミノテトラフルオロ

22

リフルオロメチル)-ジフルオロ-1.4-フェニレン ジアミン、3, 4, 5ートリス(トリフルオロメチル) ーフルオロー1,2-フェニレンジアミン、3,4,6 ートリス(トリフルオロメチル)-フルオロ-1,2-フェニレンジアミン、2, 4, 5 - トリス(トリフルオ ロメチル)-フルオロ-1,3-フェニレンジアミン、 2, 4, 6-トリス (トリフルオロメチル) -フルオロ -1, 3-フェニレンジアミン、4, 5, 6-トリス (トリフルオロメチル) -フルオロ-1, 3-フェニレ ンジアミン、テトラキス(トリフルオロメチル)-1, 2-フェニレンジアミン、テトラキス(トリフルオロメ **チル)-1,3-フェニレンジアミン、テトラキス(ト** リフルオロメチル)-1,4-フェニレンジアミン、3 ーペンタフルオロエチルートリフルオロー1,2ーフェ ニレンジアミン、4ーペンタフルオロエチルートリフル オロー1, 2ーフェニレンジアミン、2ーペンタフルオ ロエチルートリフルオロー1, 3-フェニレンジアミ ン、4 - ペンタフルオロエチルートリフルオロー1, 3 ーフェニレンジアミン、5 -ペンタフルオロエチルート リフルオロー1、3-フェニレンジアミン、2-ペンタ フルオロエチルートリフルオロー1, 4ーフェニレンジ アミン、3ートリフルオロメトキシートリフルオロー 1, 2-フェニレンジアミン、4-トリフルオロメトキ シートリフルオロー1,2-フェニレンジアミン、2-トリフルオロメトキシートリフルオロー1, 3-フェニ レンジアミン、4-トリフルオロメトキシートリフルオ ロー1,3-フェニレンジアミン、5-トリフルオロメ トキシートリフルオロー1,3-フェニレンジアミン、 2 - トリフルオロメトキシ-トリフルオロ- 1 , 4 -フ ェニレンジアミン、3、3′-ジアミノーオクタフルオ ロビフェニル、3,4'ージアミノーオクタフルオロビ フェニル、4,4′-ジアミノ-オクタフルオロピフェ ニル、2, 2′-ピス(トリフルオロメチル)-4, 4′-ジアミノヘキサフルオロピフェニル、3,3′-ピス(トリフルオロメチル)-4,4′-ジアミノヘキ サフルオロピフェニル、ピス(3-アミノーテトラフル オロフェニル) エーテル、3,4′-ジアミノーオクタ フルオロピフェニルエーテル、ピス(4 - アミノーテト。 **ラフルオロフェニル)エーテル、3,3′ージアミノー** オクタフルオロベンゾフェノン、3,4′ージアミノー オクタフルオロベンゾフェノン、4, 4′ージアミノー オクタフルオロベンゾフェノン、ピス(3 - アミノーテ トラフルオロフェニル)スルホン、3,4′ージアミノ ーオクタフルオロピフェニルスルホン、ピス(4 -アミ ノーテトラフルオロフェニル)スルホン、ピス(3-ア **ミノーテトラフルオロフェニル)スルフィド、3,4′ -ジアミノ-オクタフルオロビフェニルスルフィド、ビ** ス (4ーアミノーテトラフルオロフェニル) スルフィ ド、ビス(4 -アミノテトラフルオロフェニル)ジフル

フェニル) テトラフルオロエタン、2,2-ビス(4-アミノテトラフルオロフェニル) ヘキサフルオロプロパ ン、4,4"-ジアミノードデカフルオローローテルフ ェニル、4-アミノーテトラフルオロフェノキシー4' -アミノ-テトラフルオロフェニル-ジフルオロメタ ン、ピス(4-アミノ-テトラフルオロフェノキシ)-ジフルオロメタン、1,2-ピス(4-アミノーテトラ フルオロフェノキシ)-テトラフルオロエタン、2,2 ービス(4ーアミノーテトラフルオロフェノキシ)-へ キサフルオロプロパン、1,4-ビス(4-アミノーテ トラフルオロフェノキシ) -テトラフルオロベンゼン、 2. 6-ジアミノーヘキサフルオロナフタレン、2, 6 −ジアミノーオクタフルオロアントラセン、2, 7 − ジ アミノーオクタフルオロフェナントレン、2,6-ジア ミノーヘキサフルオロピフェニレン、2,7-ジアミノ - ヘキサフルオロジベンゾフラン、2, 6 ージアミノー ヘキサフルオロアントラキノン、2,6-ジアミノーオ クタフルオロアントロン、2,7-ジアミノーヘキサフ ルオロフェノキサチイン、2,7-ジアミノーヘキサフ ルオロチアントレン、2, 7-ジアミノーテトラフルオ 20 ロジベンゾ [b, e] 1, 4-ジオキサン、等。

【0092】これらの化合物のうちテトラフルオロー1,3-フェニレンジアミン、テトラフルオロー1,4-フェニレンジアミン、4,4'-ジアミノーオクタフルオローピフェニルは市販品として入手することができる。

【0093】その他の化合物は、例えば、I. L. クヌ ニャンツら [I. L. Knunyants, G. G. Yakobson, "Synthesis of Flu oroorganic Compounds" Spri nger-Verlag, Berlin (1985)] の合成方法、L. S. 'コプリナ [L. S. Kobrin a, G. G. Furin, G. G. Yakobso Zh. Obshch. Khim. 38, 514 (1968)] の合成方法、G. G. フリンら [G. G. Furin. S. A. Krupoder, G. G. Yakobson, Izv. Sib. Otd. A kad. Nauk SSSR Ser. Khim. Na uk vyp. 5 146 (1976)] の合成方法、 Y. コパヤシら [Y. Kobayashi, I. Ku madaki, Tetrahedron Lett. 4 7, 4095-4096 (1969)] の合成方法、 F. E. ロジャースら [米国特許第3, 356, 648 号および同第3,959,350号明細書]の合成方法 等を同様にしてまたはこれらに準じて合成することがで きる。

【0094】本発明に使用する全フッ素化ポリイミドの 前駆体である全フッ素化ポリアミド酸の製造方法は、一 般的にはN-メチル-4-ピロリドン、N, N-ジメチ ルアセトアミド、N, N-ジメチルホルムアミドなどの 24

極性有機溶媒中で上記の全フッ素化テトラカルポン酸、 その酸無水物もしくは酸塩化物、エステル化物等の反応 性誘導体と全フッ案化ジアミンとを反応させることから 成る。反応は、通常、乾燥窒素雰囲気において、室温で 7日以 上行われる。本発明においてはジアミンまた全フ ッ素化テトラカルポン酸二無水物等とも単一化合物で用 いるばかりではなく、複数の全フッ素化ジアミン、全フ ッ素化テトラカルボン酸二無水物等を混合して用いる場 合がある。その場合は、複数または単一の全フッ素化ジ アミンのモル数の合計と複数または単一の全フッ案化デ トラカルポン酸二無水物等のモル数の合計が等しいかほ ば等しくなるようにする。前述の全フッ素化ポリアミド 酸などの重合溶液において、その溶液の濃度は5~40 重量% (10~25重量%であることが好ましい)、ま た前記ポリマー溶液の回転粘度 (25℃) は、50~5 00ポアズであることが好適である。

【0095】本発明の全フッ素化ポリイミドを調製するのに使用される出発物質のうち、例えば、下記一般式(7)

[0096]

【化39】

$$\begin{array}{c} R_4 \\ R_4 \end{array} \qquad \begin{array}{c} R_5 \\ R_4 \end{array} \qquad \begin{array}{c} (7) \end{array}$$

【0097】 (式中R; は下記式 (8) または (9) 【0098】

【化40】

[0099]で表わされる四価のベルフルオロ芳香族基を示し;4個のR4はすべてカルボキシル基を表わすか、またはすべてシアノ基を示し、あるいは二組の隣接する2個のR3同士が結合してそれぞれ下式(10)

[0100]

【化41】

【0101】で表わされる二価の基を示し、R。がすべてシアノ基を示すときはR。は式(9)で表わされる基のみを示す)で表わされるペルフルオロ芳香族化合物は新規化合物である。上記一般式(7)のペルフルオロ芳香族化合物には1,4-ビス(3,4-ジカルボキシトリフルオロフェノキシ)テトラフルオロペンゼン二無水50 物、1,4-ジフルオロ無水ピロメリット酸、1,4-

ビス (3, 4-ジシアノトリフルオロフェノキシ) テトラフルオロベンゼン、<math>1, 4-ジフルオロピロメリット 酸、1, 4-ピス (3, 4-ジシアノトリフルオロフェノキシ) テトラフルオロベンゼンが含まれる。これらの化合物は下記の反応工程式<math>-1または-2に従って合成

される。 【0102】<u>反応工程式-1</u> 【0103】 【化42】

26

【0104】反応工程式-2

[0105]

【化13】

-436-

(12)

【0106】すなわち反応工程式-1において、式(1 9) のテトラフルオロフタロニトリルと式(20)のテ トラフルオロヒドロキノン(または式(20a)のその 金属塩、例えば二ナトリウム塩等)を塩基(トリメチル アミン等)の存在下に反応(極性溶媒中0~5℃で30 分間) させることにより、式(14)の1,4-ビス (3, 4-ジシアノトリフルオロフェノキシ) テトラフ ルオロベンゼンを得る。これを加水分解(60%硫酸 30 中、150℃で15時間)することにより式(13)の 1, 4-ビス(3, 4-ジカルボキシトリフルオロフェ ノキシ) テトラフルオロベンゼンを得る。生成物を脱水 (無水酢酸中、還流条件下、2時間) して、式(11) の1, 4-ビス(3, 4-ジカルボキシトリフルオロフ ェノキシ) テトラフルオロベンゼン二無水物を得る。式 (14) の1, 4-ピス(3, 4-ジシアノトリフルオ ロフェノキシ) テトラフルオロベンゼンを80%硫酸中 で加熱 (200℃、2時間) することにより一段階で加 水分解と脱水を行い、式(11)の1,4-ピス(3, 4 -ジカルポキシトリフルオロフェノキシ)テトラフル オロベンゼン二無水物を合成することもできる。

【0107】上記反応工程式-2において、式 (18)の1,4-ジフルオロテトラシアノベンゼンを加水分解(60%硫酸中、150℃で15時間)して式 (15)の1,4-ジフルオロピロメリット酸を得る。これを脱水(無水酢酸中、還流条件下、2時間)して、式 (12)の1,4-ジフルオロ無水ピロメリット酸を合成する。式 (18)の1,4-ジフルオロテトラシアノベンゼンを80%硫酸中で加熱(200℃で2時間)するこ 50

とにより一段階で加水分解と脱水を行って式(12)の 1,4-ジフルオロ無水ピロメリット酸を合成してもよ

【0108】本発明にかかる全フッ素化ポリイミドのフィルム製造法としては、通常のポリイミドフィルムの製造法が使用できる。例えば全フッ素化ポリアミド酸溶液を、アルミ板上にスピンコートし、窒素雰囲気下で70℃から350℃まで段階的に加熱(70℃20時間、160℃1時間、250℃30分、350℃1時間)し、イミド化する。その後、このアルミ板を10%塩酸に浸しアルミ板を溶解することによって、全フッ素化ポリイミドフィルムを得ることができる。

[0109]

【実施例】以下、実施例により本発明の全フッ素化ポリアミド酸、全フッ素化ポリイミドおよびそれらの出発物質について詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

[0110] 下記各例中、イミド化の確認は赤外吸収スペクトルにおけるカルボニル基の対称、および非対称伸 20 縮振動による特性吸収から行った。また、光透過性は紫外-可視吸収スペクトルを測定することで行った。

【0111】なお、実施例において全フッ素化ポリアミド酸および全フッ素化ポリイミドの合成に用いた化合物の略語と化学式を以下に示す。

【0112】10FEDA:1,4-ピス(3,4-ジ カルポキシトリフルオロフェノキシ)テトラフルオロペ ンゼン二無水物

[0113]

[化44]

【0114】 P2FDA:1, 4-ジフルオロピロメリット酸二無水物

(0115)

(化45]

$$\begin{pmatrix}
\vdots \\
\vdots \\
\vdots \\
\vdots \\
\vdots
\end{pmatrix}$$
(12)

【0116】P6FDA:1,4-ビス(トリフルオロメチル) ピロメリット酸二無水物

[0117]

(化46)

【0118】4FMPD:テトラフルオロー1,3-フェニレンジアミン

[0119]

[化47]

【0 1 2 0】 4 F P P D: テトラフルオロー 1, 4 ーフェニレンジアミン

[0121]

【化18】

【0122】8FODA: ピス(4ーアミノーテトラフ ルオロフェニル)エーテル

[0123]

(化49]

$$F = \begin{cases} F & F \\ FF & NH_2 \end{cases}$$
 (24)

【0 1 2 4】 8 F S D A : ピス (4 - アミノーテトラフルオロフェニル) スルフィド

[0125]

【化50】

30

【0126】なお、10FEDA, P2FDAは本発明 にかかる新物質である。

【0127】実施例1

三角フラスコに昇華精製された式(11)の酸無水物1 0FEDA 11.644g (20.0mmol) と昇 (20.0mmol)、およびN, N-ジメチルアセト アミド (DMAc) 86gを加えた。この溶液を窒素穿 囲気中、室温で7日間、撹拌し、全フッ素化ポリアミド 10 酸のDMAc溶液を得た。このものをアルミ板上にスピ ンコートし、窒素雰囲気下で70℃で2時間、160℃ で1時間、250℃で30分、350℃で1時間加熱イ ミド化を行った。この試料を10%塩酸水溶液に浸し、 アルミ板を溶解してポリイミドフィルムを得た。このポ リイミドフィルムの赤外吸収スペクトルを測定したとこ ろ1790cm-1にイミド基特有の吸収が現れ、イミド 化が完全に進行したことが確認できた。このポリイミド フィルムの波長0.8~1.7μmの範囲での光の吸収 スペクトルを測定し結果を図1に図示した。図1におい 20 て縦軸と横軸はそれぞれ吸光度(任意単位)と波長(μ m) を示す。図1の実線は実施例1の全フッ素化ポリイ ミド、波線は比較例1のフッ素化ポリイミドにおけるそ れぞれの吸光度の波長依存性を示し一点鎖線はフィルム 表面に付着した水分の影響のない全フッ素化ポリイミド の吸光度を示す。図1に示すとおりフィルム表面に付着 した水分に由来するわずかな吸収以外にピークは全く見 られなかった。

【0128】 実施例2~12

上に化学式と略号を示した4種の酸無水物(20.0m mol)と3種のジアミン(20.0mmol)からなる12種の組合せのうち、実施例1の組合せを除いたすべての組合せに対応する全フッ素化ポリアミド酸溶液および全フッ素化ポリイミドを、実施例1と同様の方法により得た。それらを表1に実施例2~12としてまとめる。これらのポリイミドフィルムの波長0.8~1.7μmの範囲での光の吸収スペクトルを測定したところ、実施例1と同様、フィルム表面に付着した水分に由来するわずかな吸収以外にピークは全く見られなかった。

[0129]

40 【表1】

実施例2~12で用いた酸無水物およびジアミンの種類および

重量と溶媒の重量

実施例	酸無水物	ジアミン	浴媒
2	10FEDA 11.6g	4FPPD 3.60g	86g
3	1 O F É D A	8FODA 6.88g	105g
4	1 O F E D A	8FSDA 7.20g	107g
5	P2FDA 5.8g	4FMPD 3.60g	49g
6	P 2 F D A	4FPPD 3.60g	49 g
7	P2FDA	8F0DA 6.88g	68g
8	P2FDA	8FSDA 7. 20g	70g
9	P6FDA 7.08	g 4FMPD 3.60g	61g
10	P6FDA	4FPPD 3.60g	51 g
11	P6FDA	8FODA 6.88g	79 g
12	P6FDA	8FSDA 7.20g	81 g

【0130】比較例1

三角フラスコに、以下の構造式 (26) を持つ2, 2- 20 N, N-ジメチルアセトアミド (DMAc) 87gを加 (3, 4-ジカルボキシフェニル) -ヘキサフルオロプ え、以下実施例1と同様の方法でポリイミドフィルムを 口パン二無水物 (略称:6FDA) 得た。このポリイミドフィルムの改長0.8~1.7 μ

[0131]

【化51】

【0132】8.885g(20.0mmol)と以下の構造式(27)で示される2,2′ーピス(トリフルオロメチル)-4,4′ージアミノピフェニル(略称:TFDB)

[0133]

【化52】

* [0134] 6. 405g (20. 0mmol) および か N N-ジメチルアセトアミド (DMAc) 87gを加

32

え、以下実施例 1 と同様の方法でポリイミドフィルムを得た。このポリイミドフィルムの被長0 . $8\sim1$. 7μ mの範囲での光の吸収を測定したところ、図 1 の破線で示すとおり、1 . 1μ m付近にC-II 結合の伸縮振動の 3 倍音による吸収が、また1 . 4μ m付近にはC-H 結合の伸縮振動の高調液と変角振動の結合音による吸収が、また1 . 6 5μ m付近ではC-H 結合の伸縮振動の

【0135】これらの結果から、本発明の全フッ素化ポ 【0132】8.885g(20.0mmol)と以下 30 リイミドは従来のものと比較して、光通信波長域での光の構造式(27)で示される2.2′-ピス(トリフル 透過損失率が極めて小さいことが明らかとなった。

 $[0\ 1\ 3\ 6]$ 実施例 $1\sim 1\ 2$ の全フッ素化ポリイミドおよび比較例 1 のフッ素化ポリイミドの化学構造は下記の通りである。

[0137]

実施例1

10FEDA/4FMPD

[0138]

【化53】

[0139]

実施例2

10FEDA/4FPPD

[0140] [化54]

[0141]

実施例3

10FEDA/8FODA

* [0142] [化55]

[0143]

実施例4

10FEDA/8FSDA

%[0144]

※ 【化56】

[0145]

実施例5

P2FDA/4FMPD

[0146]

【化57】

[0147]

実施例 6

P2FDA/4FPPD

[0148]

【化58】

[0149]

実施例7

P2FDA/8FODA

[0150]

【化59】

P2FDA/8FSDA

[0152]

【化60】

[0153]

40 実施例 9

P6FDA/4FMPD

[0154]

化61]

[0155]

50 実施例10

P6FDA/4FPPD

[0156]

【化62】

35

[0157]

実施例11 P6FDA/8FODA

[0158]

[化63]

[0159]

実施例12 P6FDA/8FSDA

[0160]

【化64】

[0161]

比較例1

6FDA/TFDB

[0162]

【化65】

【0163】 実施例13

ナス型フラスコに式(13)の1、4-ビス(3、4-ジカルボキシトリフルオロフェノキシ)テトラフルオロベンゼン6.18g(10mmol)と無水酢酸20.4g(0.2mol)を入れ、還流条件下で2時間反応を行った。反応終了後、フラスコを放冷して内容物を室温に戻した。折出した白色固体をろ過した後、乾燥して5.25g[1、4-(3、4-ジカルボキシトリフルオロフェノキシ)テトラフルオロベンゼン二無水物として収率90%]の生成物を得た。このものは赤外吸収スペクトルにおいて、1、4-ビス(3、4-ジカルボキシトリフルオロフェノキシ)テトラフルオロベンゼンに

36 おいて現れていた2500cm⁻¹から3700cm⁻¹の カルボン酸の水酸基に基づく吸収および1750 c m-1 近辺のカルポン酸のカルボニル基に基づく吸収が消失 し、かわりに1880cm-1と1790cm-1に酸無水 物特有のカルポニル基の吸収が現れた。また重ジメチル スルホキシド (DMSO-d゚) を溶媒として用い、テ トラメチルシラン(TMS)を内部基準としてプロトン 核磁気共鳴スペクトル(¹H-NMR)を測定した結 果、1、4-ビス(3,4-ジカルポキシトリフルオロ 10 フェノキシ) テトラフルオロペンゼンで現れていたカル ポン酸の水素に基づくシグナル (13.2ppm) が消 失し、シグナルは全く現れなかった。同様にDMSOd.を溶媒として用い、CFC1』を内部基準としてフ ッ素核磁気共鳴スペクトル(19F-NMR)を測定した 結果、4本のシグナルが観測され、その積分比は高磁場 側から4:2:2:2であった。また、元素分析におい ては計算値が炭素: 45. 39%であるのに対し、実測 値は炭素:45.18%でありよく一致していた。以上 の結果から本反応で得られた化合物は目的の式(11) の1、4-ビス(3、4-ジカルポキシフェノキシ)テ

【0164】実施例14

ナス型フラスコに式(14)の1,4-ビス(3,4-ジシアノトリフルオロフェノキシ)テトラフルオロベンゼンを5.42g(10mmol)と80%硫酸10m 1を入れ、200℃で2時間反応を行った。反応終了後フラスコを放冷して内容物を室温まで戻した。析出した白色固体をろ過し、素早く純水で洗浄した後、乾燥して5.06g[1,4-ビス(3,4-ジカルポキシトリフルオロフェノキシ)テトラフルオロベンゼン二無水物として収率87%]の生成物を得た。実施例13と同様にして生成物が目的とする式(11)の1,4-ビス(3,4-ジカルポキシトリフルオロフェノキシ)テトラフルオロベンゼン二無水物であることを確認した。

トラフルオロベンゼン二無水物であることを確認した。

[0165] 実施例15

ナス型フラスコに式(14)の1,4-ピス(3,4-ジシアノトリフルオロフェノキシ)テトラフルオロペンゼンを5.42g(10mmol)と60%硫酸を10mlmえ、150℃で15時間撹拌した。反応終了後フラスコを室温まで放置した後、析出した白色固体をろ過し純水で十分洗浄した。真空下100℃で乾燥して、白色生成物を5.62g[1,4-ピス(3,4-ジカルボキシトリフルオロフェノキシ)テトラフルオロペンゼンとして収率91%]を得た。このものは赤外吸収スペクトルにおいて、1,4-ピス(3,4-ジシアノトリフルオロフェノキシ)テトラフルオロペンゼンにおいて、1,4-ピス(3,4-ジシアノトリフルオロフェノキシ)テトラフルオロペンゼンにおいて、1,4-ピス(3,4-ジシアノトリフルオロフェノキシ)テトラフルオロペンゼンにおいて、1,4-ピス(3,4-ジシアノトリフルオロフェノキシ)テトラフルオロペンゼンにおいて、1,4-ピス(3,4-ジシアノトリフルオロフェノキシ)テトラフルオロペンゼンにおいて、1,4-ピス(3,4-ジシアノトリフルオロフェノキシ)テトラフルオロペンゼンにおいてのカルボロン酸の水酸基に基づく吸収および1750cm-1近辺にカルボン酸のカルボニル基に基づく吸収が

50

新たに現れた。また「II-NMRでは重ジメチルスルホ キシド中、TMSを内部標準として測定した結果13. 2 p p m にカルボン酸の水素に基づくシグナルが現れ た。また19F-NMRではDMSO-d。中、CFC1 。を内部標準として測定した結果、4本のシグナルが観 測され、その積分比は高磁場側から4:2:2:2であ った。また、元素分析においては計算値が炭素:42. 74%、水素: 0. 65%であるのに対し実測値は炭 素;42.50%、水素;0.63%であり、よく一致 していた。以上の結果から本反応で得られた化合物は目 的の式 (13) の1, 4-ビス (3, 4-ジカルポキシ トリフルオロフェノキシ) テトラフルオロベンゼンであ ることが確認された。

[0166] 実施例16

三角フラスコに式(19)のテトラフルオロフタロニト リルを4.0g(20mmol)と式(20)のテトラ フルオロハイドロキノンを0.91g(5mmol)お よびN、N-ジメチルホルムアミド(DMF)を20m 1加えた。この混合物の入った三角フラスコを氷水浴中 に漬け混合物を0~5℃に保った。この混合物にトリエ チルアミン1. 01g (10mmol) を10分間かけ て滴下し、その温度で20分間撹拌した後、さらに室温 で30分間撹拌した。内容物を0.2リットルの希塩酸 中にあけたところ油状物質が下層に折出した。油状物質 を分離した後、水で洗浄し乾燥した。このものをメタノ ールで再結晶し、1、12gの生成物 [1, 4-ビス (3, 4-ジシアノトリフルオロフェノキシ)テトラフ ルオロベンゼンとして収率41%]を得た。このものは 赤外吸収スペクトルにおいて、2250cm-1にシアノ 基に基づく吸収が見られた。DMSO-d。を溶媒とし 30 て用いTMSを内部基準として「H-NMRを測定した ところ、シグナルは全く観測されず、水素は存在しない ことが明らかとなった。また、DMSO-d。を溶媒と して用いCFC1。を内部基準として18F-NMRを測 定した結果、4本のシグナルが観測され、その積分比は 高磁場側から4:2:2:2であった。また元素分析に おいては計算値が炭素;48.69%、窒素;10.3 3%であるのに対し、実測値は炭素; 18.83%、窒 素:10、21%であり、よく一致していた。以上の結 果から本反応で得られた化合物は目的の式(14)の 1. 4-ピス(3, 4-ジシアノトリフルオロフェノキ シ) テトラフルオロベンゼンであることが確認された。

[0167] 実施例17

三角フラスコに式(19)のテトラフルオロフタロニト リルを40.0g(0.2mol)とN, N-ジメチル ホルムアミド (DMF) を0.1リットル加えた。この 混合物の入った三角フラスコを氷水浴中に漬け、混合物 を0~5℃に保った。次にこの混合物に式(20a)の テトラフルオロハイドロキノンのニナトリウム塩11. 3 g (0.05mol) を 10 分間かけて加えた。その 50 ゼンにおいて現れていたシアノ基に基づく 2250cm

.38

温度で20分間撹拌し、さらに室温で30分間撹拌し た。その後の処理および生成物の固定は実施例16と同 様に行い、14.6g(収率54%)の式(14)の 1, 4-(3, 4-ジシアノトリフルオロフェノキシ) テトラフルオロベンゼンを得た。

【0168】 実施例18

ナス型フラスコに式(15)の1,4-ジフルオロピロ メリット酸を2. 90g (10mmol) と無水酢酸を 10.2g(0.2mol)入れ、還流条件下で2時間 反応を行った。反応終了後フラスコを放冷して内容物を 室温まで戻した。析出した白色固体をろ過し、後乾燥し て1.82g(1,4-ジフルオロ無水ピロメリット酸 として収率72%)の生成物を得た。このものは赤外吸 収スペクトルにおいて、1, 4-ジフルオロピロメリッ ト酸において現れていた2500cm⁻¹から3700c m-1のカルボン酸の水酸基に基づく吸収および1750 c m-1 付近のカルポン酸のカルポニル基に基づく吸収が 消失し、かわりに1850cm⁻¹と1800cm⁻¹に酸 無水物特有のカルポニル基の吸収が現れた。DMSOd。 を溶媒として用いTMSを内部基準として ^1H-N MRを測定したところ、シグナルは全く観測されず、水 素は存在しないことが明らかとなった。また、DMSO - d。 を溶媒として用いCFC l 』を内部基準として¹9 F-NMRを測定した結果、-118.7ppmに一重 線が観測された。元素分析においては計算値が炭素; 4 7. 27%であるのに対し、実測値は炭素;47. 38 %であり、よく一致していた。以上の結果から本反応で 得られた化合物は目的の式(12)の1,4-ジフルオ 口無水ピロメリット酸であることを確認した。

[0169] 実施例19

ナス型フラスコに式 (18) の1, 4-ジフルオロテト ラシアノベンゼンを2. 14g (10mmol) と80 %硫酸10mlを入れ、200℃で2時間反応を行っ た。反応終了後フラスコを放冷して内容物を室温まで戻 した。析出した白色固体をろ過し、素早く純水で洗浄し た後乾燥して1、89g(1,4-ジフルオロ無水ピロ メリット酸として収率74%)の生成物を得た。実施例 18と同様にして生成物が目的とする式(12)の1, 4-ジフルオロ無水ピロメリット酸であることを確認し た。

【0170】実施例20

ナス型フラスコに式 (18) の1, 4-ジフルオロテト ラシアノペンゼンを10.88g(51mmol)と6 0%硫酸を125ml入れ、150℃で5時間撹拌し た。室温まで放置した後折出した白色固体をろ過し、純 水で十分洗浄した。真空下100℃で乾燥して、白色生 成物を12.86g(1,4-ジフルオロピロメリット 酸として収率87%)を得た。このものは赤外吸収スペ クトルにおいて、1,4ージフルオロテトラシアノベン

-1の吸収が消失し、かわりに2500cm-1から370 0 c m-1 にカルポン酸の水酸基に基づく吸収および17 00 c m-1 近辺にカルボン酸のカルボニル基に基づく吸 収が新たに現れた。DMSO-d。を溶媒として用いC FC1。を内部基準として18F-NMRを測定した結 果、-119.3ppmに一重線が観測された。また、 元素分析においては計算値が炭素;36.11%,水 素; 1. 52%であるのに対し、実測値は炭素; 36. 26%、水素: 1. 48%であり、よく一致していた。 以上の結果から本反応で得られた化合物は目的の式 (1 10 ド、破線は比較例 1 のポリイミドの吸光度を示し、一点 5) の1. 4-ジフルオロピロメリット酸であることが 確認された。

【発明の効果】本発明の全フッ素化ポリイミドは従来の ものと比較して光通信波長域での光透過損失率が極めて 少なくこれを主要構成要素とするポリイミド光学材料は 耐熱性と光通信波長域における低光損失とを同時に有す

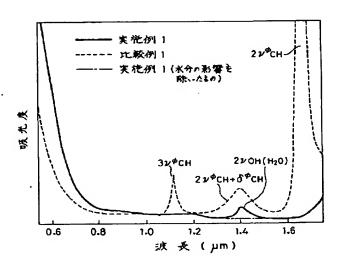
40

【図面の簡単な説明】

[0171]

【図1】ポリイミドにおける吸光度の波長依存性を示す グラフであり、実線は実施例1の全フッ素化ポリイミ 鎖線は全フッ素化ポリイミドの吸光度から基板上に付着 した水分による吸収の影響を除いたものを示す。

[図1]



フロントページの続き

(31)優先権主張番号 特顯平3-106557

(32)優先日

平3 (1991) 4月12日

日本 (JP) (33)優先権主張国

(72)発明者 山本 二三男

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日 本電信電話株式会社内